

Silicon Power Schottky Diode

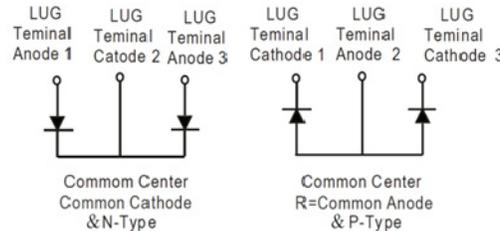
$V_{RRM} = 20\text{ V} - 40\text{ V}$

$I_{F(AV)} = 120\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 20 V to 40 V V_{RRM}
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive

Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBRT12020(R)	MBRT12030(R)	MBRT12035(R)	MBRT12040(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		20	30	35	40	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		14	21	25	28	V
DC blocking voltage	V_{DC}		20	30	35	40	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBRT12020(R)	MBRT12030(R)	MBRT12035(R)	MBRT12040(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 125\text{ }^\circ\text{C}$	120	120	120	120	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	800	800	800	800	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 60\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.70	0.70	0.70	0.70	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = 100\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1 10 30	1 10 30	1 10 30	1 10 30	mA

Thermal characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	MBRT12020(R)	MBRT12030(R)	MBRT12035(R)	MBRT12040(R)	Unit
Thermal resistance, junction-case (per leg)	$R_{\theta JC}$		0.80	0.80	0.80	0.80	$^\circ\text{C/W}$

Figure.1-Typical Forward Characteristics

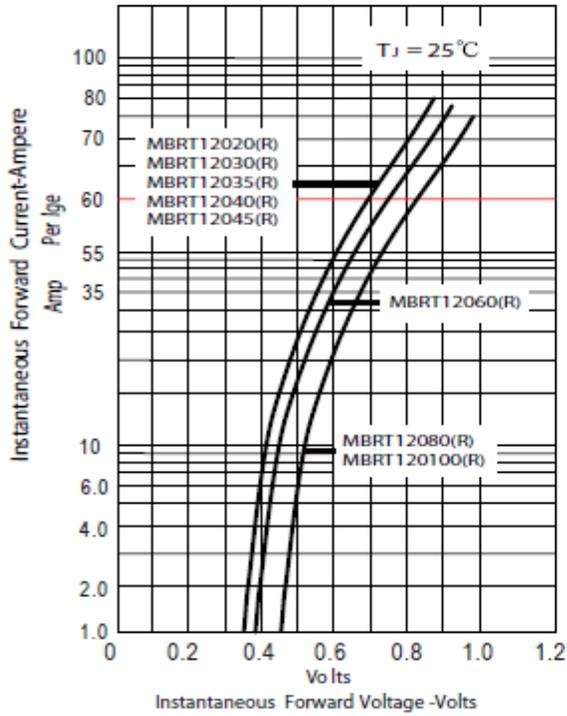


Figure.2-Forward Derating Curve

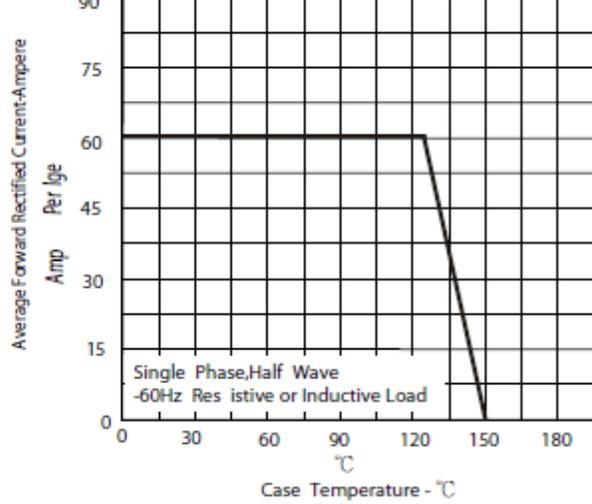


Figure.3-Peak Forward Surge Current

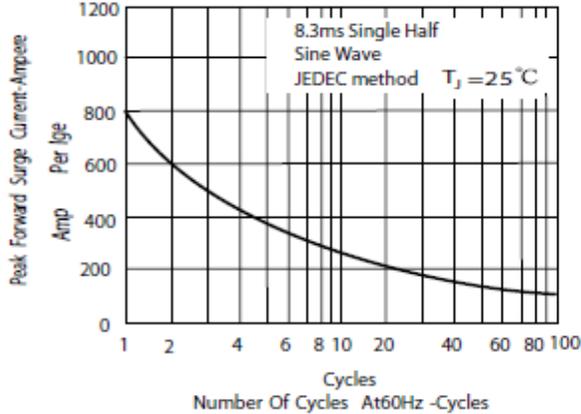
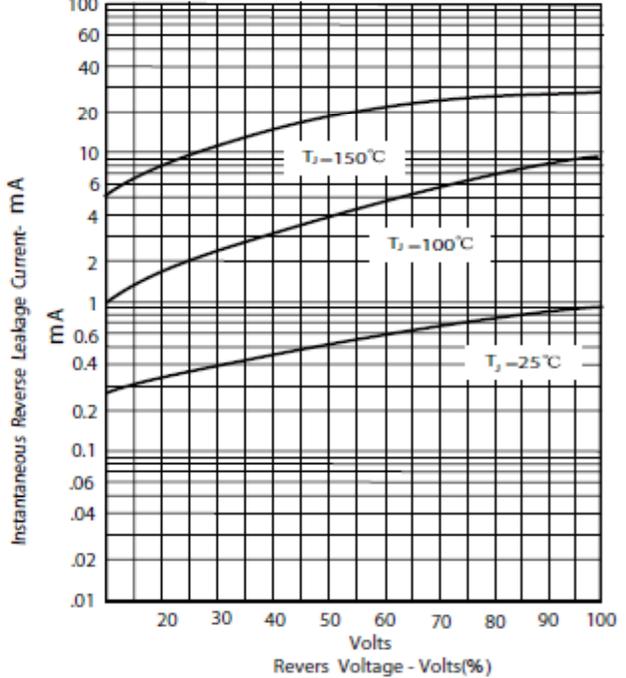
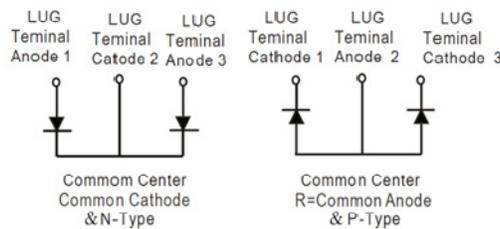
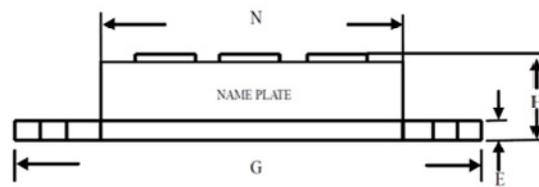
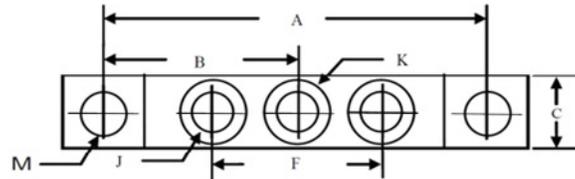


Figure.4-Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3.150	NOM	80.01	NOM
B	1.565	1.585	39.75	40.26
C	.700	.800	17.78	20.32
E	.119	.132	3.02	3.35
F	1.327	REF	33.72	REF
G	3.55	3.65	90.17	92.71
H	----	.73	----	18.30
J	1/4-20 UNC FULL			
K	.472	.511	12	13
M	.275	.295	6.99	7.49
N	2.38	2.46	60.5	62.5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.